

右記のポスターセッションの分科では、それぞれ別会場にて5分の口頭講演の場を設けることにしました。このショートプレゼンテーションは、発表者の側においては多数の人に発表を聞いて考えるチャンスが広がることになり、また聴講者においても、その全体の概要を予め知るうえで助けになるものと思われま

す。ショートプレゼンテーションに引き続いて同日にそれぞれのポスターセッションが行われます。ショートプレゼンテーションのあるポスター講演者は各自の講演日時を必ず確認され、登壇時間に遅れることがないようにご協力をお願いします。

なお、この講演では討論は行われませんので、5分の持ち時間終了のベルが鳴った時は直ちに講演を中止してください。時間を有効活用するため、発表者は前の講演が終了すると同時に登壇できるよう、次発表者席にて備えていただきたいと思います。

5. ショートプレゼンテーション (5分講演)

中分類分科名	月日	講演番号	ショート プレゼンテーション	ポスターセッション	ポスター会場 (第一or第二)
2.1 計測・制御技術	3/24(木)	24a-KU-1～18	10:30～12:00	13:00～15:00	第二
3.3 機器・デバイス光学	3/25(金)	25a-KU-1～17	9:30～11:10	15:30～17:30	第二
6.1 強誘電体薄膜	3/24(木)	24a-BE-1～27	9:30～12:00	13:00～15:00	第一
	3/26(土)	26a-BE-2～28	9:45～12:00	13:00～15:00	第一
7.1X 線技術	3/24(木)	24a-KX-1～18	9:30～11:00	15:30～17:30	第二
10.1 新物質創成	3/25(金)	25a-KM-1～16	10:00～11:20	13:00～15:00	第二
	3/26(土)	26a-KM-1～15	10:00～11:15	13:00～15:00	第二
11.2 薄膜,厚膜,テープ作製プロセスおよび結晶成長	3/25(金)	25a-KJ-1～14	10:30～11:40	13:00～15:00	第二
12.9 有機トランジスタ	3/24(木)	24a-BU-1～20	10:00～11:40	15:30～17:30	第二
	3/25(金)	25a-BU-1～20	10:00～11:40	15:30～17:30	第二
12.10 ナノバイオテクノロジー	3/24(木)	24a-BV-1～25	9:30～11:45	13:00～15:00	第二
	3/25(金)	25a-BV-1～24	9:00～11:10	13:00～15:00	第一
合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」	3/24(木)	24a-BS-2～31	9:15～12:00	15:30～17:30	第一
	3/25(金)	25a-BS-1～35	9:00～12:10	15:30～17:30	第一
	3/26(土)	26a-KL-1～33	9:00～12:00	15:30～17:30	第一

5.1 半導体レーザー・発光/受光素子, 8.2 プラズマ診断・計測, 9.5 新機能材料・新物性, 13.5 Si プロセス技術, 14.4 超高速・機能デバイス, 15.8 結晶評価, ナノ不純物・結晶欠陥, 18.2 教育ではショートプレゼンテーションは行われません。ショートプレゼンテーションでもPCプロジェクトによる講演を行います。該当会場の座長は講演が定められた時間内に終了するようにご協力をお願いします。

■ ポスターセッションのご案内

ポスターセッションは右記分科において実施します。

このセッションは研究成果をポスター(図表, 写真を含む)の形にまとめて、これを指定されたパネルに展示することによって行われるものです。この方式による発表では、発表者と参加者との実質的な深い議論が期待でき、参加者は聴きたい講演のみに集中して聞き歩きできる利点をもっていますので、研究者相互の理解には一助になるものと思われま

す。展示方法、発表要領は次のとおりです。

大分類分科名	中分類分科名
2. 計測・制御	2.1 計測・制御技術
3. 光	3.3 機器・デバイス光学
5. 光エレクトロニクス	5.1 半導体レーザー・発光/受光素子
6. 薄膜・表面	6.1 強誘電体薄膜
7. ビーム応用	7.1X 線技術
8. プラズマエレクトロニクス	8.2 プラズマ診断・計測
9. 応用物性	9.5 新機能材料・新物性
10. スピントロニクス・マグネティクス	10.1 新物質創成
11. 超伝導	11.2 薄膜,厚膜,テープ作製プロセスおよび結晶成長
12. 有機分子・バイオエレクトロニクス	12.9 有機トランジスタ
	12.10 ナノバイオテクノロジー
13. 半導体A(シリコン)	13.5 Si プロセス技術
14. 半導体B(探索的材料・物性・デバイス)	14.4 超高速・機能デバイス
15. 結晶工学	15.8 結晶評価, ナノ不純物・結晶欠陥
18. 応用物理一般	18.2 教育
合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」	

※ 上記の中分類分科内の全ての講演がポスターセッションではありません。ご注意ください。

1 展示方法

イ) 備え付けのパネル(1講演につき、たて120cm, よこ180cmのパネル)が用意されています。予め講演番号, 講演題目, 所属, 氏名を記入した用紙(たて15cm, よこ85cm)を各自が用意し、これをパネル上部に取り付けてください。

ロ) 次にパネルに、各自が用意したポスター, 図表, 写真などを、適宜レイアウト(例えば研究目的, 研究方法, 研究成果といった順に)して掲示してください。

ハ) ポスターの大きさ, 形式は問いませんが、できるだけ見やすく、大きく書いてください。その際ポスターがパネルにうまく収まるように、予めポスターの割り付けを検討しておくとう便利です。

ニ) すべての掲示は本部で用意したピンで行ってください。糊の使用はご遠慮ください。

2 発表要領

イ) 展示持ち時間120分(+準備20分, 撤収10分)

	午前のセッション		午後のセッション	
準備	9:10～9:30	12:40～13:00	15:10～15:30	
説明・討論	9:30～11:30	13:00～15:00	15:30～17:30	
撤収	11:30～11:40	15:00～15:10	17:30～17:40	

ロ) 展示時間のうち、講演番号の順番が奇数の方は前半の1時間、偶数の方は後半の1時間はその場を離れないようにして説明, 討論を行ってください。コアタイム(拘束時間)以外の時間についても、できる限りその場において、討論を行えるよう努めてください。連名者があって二人以上で出席できる場合は、常に一人はその場において説明・討論をしてください。

ハ) 展示持ち時間が終了したら、直ちに講演者各自で展示物を撤収してください。